# PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

DATE OF APPLICATOIN : September 10, 2002

APPLICATION NO. : 2002-264553

APPLICANT (S) : ANELVA Corporation

Dated this 13 day of June 2003

Shinichiro Ota Commissioner, Patent Office

Certificate No. 2003-3046473

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 9月10日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-264553

[ ST.10/C ]:

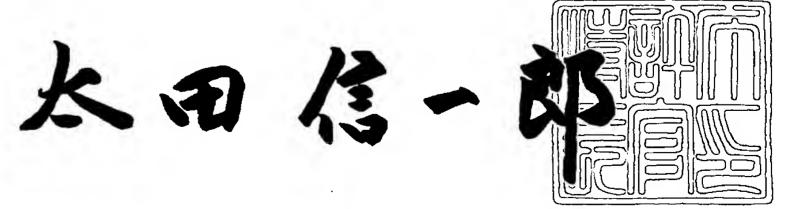
[JP2002-264553]

出 願 人 Applicant(s):

アネルバ株式会社

2003年 6月13日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】

特許願

【整理番号】

TA2002034

【提出日】

平成14年 9月10日

【あて先】

特許庁長官

殿

【国際特許分類】

G01N 27/62

H01J 49/10

【発明者】

【住所又は居所】

東京都府中市四谷5丁目8番1号 アネルバ株式会社内

【氏名】

平野 芳樹

【発明者】

【住所又は居所】

東京都府中市四谷5丁目8番1号 アネルバ株式会社内

【氏名】

塩川 善郎

【特許出願人】

【識別番号】

000227294

【住所又は居所】

東京都府中市四谷5丁目8番1号

【氏名又は名称】

アネルバ株式会社

【代表者】

今村 有孝

【代理人】

【識別番号】

100094020

【弁理士】

【氏名又は名称】

田宮 寛祉

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

007766

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

9104569

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 反射型イオン付着質量分析装置

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 金属イオン発生領域で発生させた正電荷の金属イオンを付着 領域で被測定ガスの分子に付着させて付着イオンを生成し、その後、質量分析領 域で前記付着イオンの質量分析を行う装置において、

前記金属イオン発生領域と前記質量分析領域は共通の領域として形成され、前記付着領域は前記共通の領域に隣接して設けられ、

前記付着領域に、前記金属イオン発生領域から前記付着領域内に導入された前 記金属イオンを反射させることにより前記質量分析領域へ導く静電界を形成する 静電界発生手段を備えたことを特徴とする反射型イオン付着質量分析装置。

【請求項2】 反射によって前記金属イオンの並進エネルギを低下させることを特徴とする請求項1記載の反射型イオン付着質量分析装置。

【請求項3】 前記金属イオンを反射させる前記静電界によって付着イオンを加速・収束させることを特徴とする請求項1または2記載の反射型イオン付着質量分析装置。

【請求項4】 前記静電界発生手段は前記金属イオンまたは前記付着イオンを透過させるグリッドを使用せずに静電界を形成することを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の反射型イオン付着質量分析装置。

【請求項5】 静電界に補正電界を重畳し、前記金属イオンおよび付着イオンの軌道を調整することを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の反射型イオン付着質量分析装置。

【請求項6】 静電界の強度分布が回転楕円体であることを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の反射型イオン付着質量分析装置。

【請求項7】 静電界の強度分布が球体であることを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の反射型イオン付着質量分析装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明はイオン付着質量分析装置に関し、特に、被測定ガスの成分を高感度かつ高精度で測定する反射型イオン付着質量分析装置に関する。

[0.002]

【従来の技術】

イオン付着質量分析方法(IAMS; Ion Attachment Mass Spectrometer)は、被測定ガスの分子を解離(フラグメント)させることなくイオン化し、当該分子イオンを質量分析領域に移動させてその質量分析を行う方法である。イオン付着質量分析方法を実施する装置については、従来、いくつかの特許文献  $1 \sim 8$  あるいは非特許文献  $1 \sim 5$  で提案されている。

[0003]

本願発明との関係で従来のイオン付着質量分析装置の基本的構成を図12を参照して説明する。図12において、1は金属イオン発生領域、2は付着領域、3は質量分析領域である。金属イオン発生領域1と付着領域1は同じ真空環境として形成される。付着領域1と質量分析領域3の間には隔壁6が設けられる。隔壁6には孔6aが形成されている。金属イオン発生領域1にはエミッタ4が配置されている。図中5は金属イオンと付着イオンの移動軌跡を示す。質量分析領域3内には質量分析計8が設けられ、かつ真空ポンプ7が付設されている。

[0004]

金属イオン発生領域1、付着領域2、質量分析領域3は、すべて大気圧以下の減圧雰囲気となっている。金属イオン発生領域1では、アルカリ金属の酸化物であるエミッタ4が加熱され、Li<sup>+</sup>などの正電荷の金属イオンが発生している。エミッタ4には図示しない電源から電流が供給され、加熱される。金属イオンは電界によって金属イオン発生領域1から付着領域2に輸送される。付着領域2には被測定ガス(試料ガス)の導入機構30によって被測定ガスが導入されている。被測定ガスの分子における電荷の片寄りのある場所に金属イオンが緩やかに付着する。金属イオンが付着した分子は全体として正電荷を持つイオンとなって、付着イオンが生成される。

[0005]

上記付着が行われた時に余分となるエネルギ、すなわち余剰エネルギは非常に

小さいため、解離は発生しない。しかし、金属イオンが付着イオンから再び脱離しないように、余剰エネルギを雰囲気ガスとの衝突により取り除かなければならない。また付着の効率を上げるため、高い電圧によってエミッタ4から引き出された金属イオンを雰囲気ガスとの衝突により、並進エネルギ1eV以下まで減速させなければならない。1eV以上の並進エネルギを持つ金属イオンは被測定ガス分子と接触しても、ほとんどが付着せずに離れてしまう。この2つの効果を最大とするために、従来のイオン付着質量分析装置では付着領域2の圧力を100Pa程度にするのが一般的であった。ただし、100Paの圧力ではイオンの動きがスムーズではなく、測定結果の定量性に問題が生じる。そこで最近では、減速は電界によって行うこととして、付着領域の圧力を1Pa程度で動作させる方法が開発されつつある。

[0006]

上記のごとくして生成した付着イオンは、電界によって再び加速され、孔付き隔壁6を通過して質量分析領域3に輸送される。Qポール型質量分析計など電磁気力を利用した質量分析計8が、付着イオンを質量ごとに分別して計測する。質量分析計は通常10<sup>-3</sup>Pa以下の圧力でしか動作できないので、孔付き隔壁6によって圧力差を発生させている。図12は一般的な従来例を示したが、個々の従来では差動排気領域の有無や真空ポンプの数などが異なっている場合もある。

[0007]

また従来では電子付着質量分析装置も提案されている(特許文献7)。この特許文献に開示される電子付着質量分析装置によれば、中性のガスに電子を付着させて全体として負のイオンにして質量分析する。さらに電界を利用して電子の速度を減速させ、対象のガス分子に電子を付着させて負イオンを作る技術思想も提案されている(特許文献8)。この特許文献によれば、ミラー静電界を利用して電子の速度を0またはそれに近い値にし、電子のガスへの付着を可能にしている

[0008]

【特許文献1】

特開平6-11485号公報

# 【特許文献2】

特開2001-174437号公報

#### 【特許文献3】

特開2001-351567号公報

#### 【特許文献4】

特開2001-351568号公報

## 【特許文献5】

特開2002-124208号公報

#### 【特許文献 6】

特開2002-170518号公報

#### 【特許文献7】

米国特許第4,933,551号明細書

#### 【特許文献8】

米国特許第4,649,278号明細書

# 【非特許文献1】

ホッジ (Hodge), 「アナリティカル・ケミストリ (Analytcal Chemistry))」, (米国), 1976, vol.48, No.6, P.825

#### 【非特許文献2】

ボムビック(Bombick), 「アナリティカル・ケミストリ (Analytcal Chemistry)」, (米国), 1984, vol.56, No.3, P.396

# 【非特許文献3】

藤井, 「アナリティカル・ケミストリ (Analytcal Chemistry)」, (米国), 1986, vol.61, No.9, P.1026

#### 【非特許文献4】

藤井, 「ケミカル・フィジクス・レターズ (Chemical Physics Letters)

」, (米国), 1992, vol.191, No.1.2, P.162

#### 【非特許文献5】

藤井, 「リャピド・コミュニケーション・イン・マス・スペクトロメトリ (Rapid Communication in Mass Spectrometry)」, (米国), 2000, vol.14, P

.1066

[0009]

# 【発明が解決しようとする課題】

従来のイオン付着質量分析装置はいずれも分子を解離させずにイオン化することができ、被測定ガスの成分同定(定性分析)に関しては正しく行うことができた。これは他の手法を凌駕するものであって、科学技術や産業分野からイオン付着質量分析装置に大きな期待がかけられている。しかしながら、イオン付着質量分析装置には測定感度が不十分で微量成分の検出が難しいという弱点があった。特に、定量性を向上させる目的で付着領域2の圧力を1Paとする方法では測定感度はより悪化してしまうので、測定感度の不足は深刻な問題となっている。

# [0010]

感度不足の理由について説明する。図12に示すごとく、従来のイオン付着質量分析装置では、金属イオン発生領域1、付着領域2、質量分析領域3の順番でそれぞれ隣接して位置しており、エミッタ4と質量分析計8は付着領域2を挟んでほぼ一直線上に設置されている。従って、エミッタ4から発生した金属イオンは付着領域2にて付着イオンに変化しても、方向を変えずにそのまま質量分析計8へ直進する。もし途中で並進エネルギの変化がない場合には、イオンを直進させる従来の方式はイオンの制御が最も容易で確実なものとなる。しかし、実際には途中で大幅な減速と加速が行われており、従来の方式では決して十分な制御が行われていない。

#### [0011]

具体的には、エミッタ4からの金属イオンの引出し・輸送のため最初は金属イオンの並進エネルギは10~20eVとなっているが、付着領域2では付着効率を向上させるために1eV以下まで減速している。その後、生成した付着イオンは加速され、再び10~20eVの並進エネルギで質量分析計8に輸送される。このような大幅な減速が行われると、個々のイオンがもともと持っている横方向の並進エネルギ成分が強く出現し、イオンは空間的に大きく広がってしまう。このようにほぼ停止状態で空間に広がっているイオンを、再び同じ方向に加速させて集束させることは非常に困難となる。そのため、実際に検出される付着イオン

は、生成された付着イオンの総量よりも桁違いに小さなものとなっている。

[0012]

特に、定量性を向上するためガスによる衝突を使わず、静電界のみにて減速を 行う場合は、この問題がより深刻となる。静電界だけでは、イオンを減速・停止 させた後再び同じ方向に加速させることは本質的に不可能となる。時間的に変化 する電界を用いればこれは可能であるが、輸送・付着のプロセスが断続的となる ので、時間平均での効率は非常に低下する。例えば、特許文献8や非特許文献5 では、時間的に変化する電界を利用している。

[0013]

以上のように、直進させながらの減速・加速におけるイオン制御の問題が従来のイオン質量分析装置における測定感度不足の大きな理由となっている。

[0014]

エミッタ4と質量分析計8が同一直線上に配置されかつ対向している状態にある従来のイオン付着質量分析装置では、以上の測定感度不足以外についても、次 ぎのような問題点もあった。

[0015]

- (1)質量分析計8に擾乱(エミッタ4からの光や中性粒子など)が入りやすい。
  - (2) エミッタ4 が劣化しやすい。
  - (3)装置サイズが大きい。
  - (4) 直接モニタリングが難しい。

[0016]

上記の問題点について説明する。高温に加熱されているエミッタ4からは光や中性粒子なども発生するが、これらは電荷を持たないため直進し対向している質量分析計11に入り込んでバックグランドレベルの上昇や電極の汚れなどを引き起こす。特に、質量分析計11として一般的なQポール型質量分析計は軸に平行な4本のポールから構成されているため、正面から直進して来る、すなわち軸に平行に飛来してくる光や中性粒子はQポール型質量分析計の奥深くまで入り込み、極めて深刻な問題となる。

#### [0017]

エミッタ4は、被測定ガスが導入される付着領域2と真空的に同じ領域に位置している。そのため、高温に加熱されているエミッタ表面は常に被測定ガスに曝され、エミッタ表面で被測定ガスが反応を起こし、エミッタ表面に生成物が堆積したり、あるいは表面をエッチングしてエミッタ4の劣化を引き起こす。

#### [0018]

また装置の構造としては、金属イオン発生領域1、付着領域2、質量分析領域3の3つが順に並んでいるので、全体の装置サイズが大きくなる。また被測定ガスが導入されるべき付着領域2が装置の中央部に位置しているため、被測定ガス成分の変化を引き起こす配管を使わずに被測定部と付着領域とを直結する直接サンプリングが難しくなっている。

#### [0019]

さらに特許文献7に開示される電子付着質量分析法では、電子を減速させる工夫がなされている。しかし、電子付着質量分析法は負イオンになりやすい負性ガスのみに電子が付着し、またほとんどの場合、電子付着後に解離が発生する、という特性を有する。イオン付着質量分析法ではそのような特性がなく、まったく異なるイオン化法である。さらに電子付着では付着される電子はガスの電子軌道まで電子が侵入するのに対して、イオン付着では金属イオンはガスと緩やかな結合関係を作り出す。以上のことから、電子付着質量分析法は一部の学術研究のための非常に特殊な分析法に留まるのに対して、イオン付着質量分析法は幅広い産業に利用される極めて一般的な分析方法として位置づけることができる。

#### [0020]

本発明の目的は、上記課題に鑑み、高い測定感度により微量成分を検出できると共に、質量分析計の擾乱、エミッタ劣化、装置サイズ、直接サンプリング等の問題を解決し、さらに産業に幅広く適用できる一般的な分析方法としての反射型イオン付着質量分析装置を提供することにある。

#### [0021]

【課題を解決するための手段および作用】

本発明に係る反射型イオン付着質量分析装置は、上記目的を達成するために、

次の通り構成される。

[0022]

第1の反射型イオン付着質量分析装置(請求項1に対応)は、金属イオン発生 領域で発生させた正電荷の金属イオンを付着領域で被測定ガスの分子に付着させ て付着イオンを生成し、その後、質量分析領域で付着イオンの質量分析を行う装 置であって、金属イオン発生領域と質量分析領域は共通の領域として形成され、 付着領域は共通の領域に隣接して設けられる。付着領域には、金属イオン発生領 域から付着領域内に導入された金属イオンを反射させることにより質量分析領域 へ導く静電界を形成する静電界発生部を備える。

[0023]

第2の反射型イオン付着質量分析装置(請求項2に対応)は、上記の構成において、好ましくは、反射によって金属イオンの並進エネルギを低下させることを特徴とする。

[0024]

第3の反射型イオン付着質量分析装置(請求項3に対応)は、上記の構成において、好ましくは、金属イオンを反射させる静電界によって付着イオンを加速・収束させることを特徴とする。

[0025]

第4の反射型イオン付着質量分析装置(請求項4に対応)は、上記の構成において、好ましくは、静電界発生部は金属イオンまたは付着イオンを透過させるグリッドを使用せずに静電界を形成することを特徴とする。

[0026]

第5の反射型イオン付着質量分析装置(請求項5に対応)は、上記の構成において、好ましくは、静電界に補正電界を重畳し、金属イオンおよび付着イオンの 軌道を調整することを特徴とする。

[0027]

第6の反射型イオン付着質量分析装置(請求項6に対応)は、上記の構成において、好ましくは、静電界の強度分布がほぼ回転楕円体であることで特徴づけられる。

[0028]

第7の反射型イオン付着質量分析装置(請求項7に対応)は、上記の構成において、好ましくは、静電界の強度分布がほぼ球体であることを特徴とする。

[0029]

【作用】

前述した問題点は、すべてエミッタと質量分析計が付着領域を挟んでほぼ一直線上にて対向して設置され、金属イオンおよび付着イオンが直進していることに起因している。そこで、エミッタと質量分析計を同一の領域に並べて設置し、金属イオンを付着領域で反射させて反射の過程で付着イオンを生成、戻ってくる付着イオンを集束させ、質量分析計に導くようにする。これにより、上記問題について基本的な解決に導くことができる。

[0030]

本発明が依っている静電界におけるイオンの特徴的な挙動、すなわち「静電界では、同じ並進エネルギを持つイオンは、質量に拘らず全く同じ軌道を飛行する」について確認する。重いイオンは、軽いイオンに比べると同じ並進エネルギでも実際の速度は遅い。そのため、静電界を通過する時間は長くなり、静電界から受ける力は強くなる。しかし、質量が重いので、加速度(=力/質量)は同じとなり、軌道としては軽いイオンと全く同じになる。静電界の中で、金属イオンは途中で付着イオンとなってイオンの質量は増加するが、軌道の変化は全く生じない。

[0031]

本発明の構成では、以下のごとき作用・効果に基づいて、前述した課題の解決が行われる。

[0032]

- (a) 静電界によって鋭角で反射する場合、金属イオンは十分に減速するので付着の効率は非常に高くなる。
- (b)減速時に生成された付着イオンは、同じ静電界によってそのまま逆方向 に加速されるので、精度の良いイオン制御が行われる。
  - (c) 静電界の形状を適切にすれば、金属イオンが空間的に広がっても付着イ

オンは逆の軌道をたどって集束するので、効率の良い検出が行える。

- (d)エミッタと質量分析計が対向していないので、エミッタからの光や中性 粒子は質量分析計に侵入できず、常に正常な質量分析が行える。
- (e)エミッタが10<sup>-3</sup>Pa以下であるべき質量分析計と同じ領域にあるため、被測定ガスとの接触が大幅に低減され、エミッタの劣化が生じない。
- (f)独立した金属イオン発生領域がなくなるので、装置サイズを小さくできる。
- (g)付着領域が装置の先端に位置するので、被測定部と直結する直接サンプリングが行える。

[0033]

【発明の実施の形態】

以下に、本発明の好適な実施形態を添付図面に基づいて説明する。

[0034]

実施形態で説明される構成、形状、大きさおよび配置関係については本発明が理解・実施できる程度に概略的に示したものにすぎず、また数値および各構成要素の組成(材質)については例示にすぎない。従って本発明は、以下に説明される実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に示される技術的思想の範囲を逸脱しない限り様々な形態に変更することができる。

[0035]

図1は本発明の第1実施形態に係るイオン付着質量分析装置の内部構造を概略的に示す縦断面図である。図1において、図12で説明した要素と実質的に同一の要素には同一の符号を付している。

[0036]

図1において、2は付着領域、10は金属イオン発生と質量分析の共通領域である。付着領域2は装置の図中左端部に単独の室として形成される。付着領域2と共通領域10の間には2つの孔11a,11bが形成された隔壁11が配置され、2つの領域が分離される。共通領域10にはエミッタ4と質量分析計8が配置される。エミッタ4は孔11aに対応して配置され、質量分析計8は孔11bに対応して配置されている。エミッタ4から放出された金属イオンは孔11bを

通って付着領域2内に入る。付着領域2には二重半球型の反射器9が設けられている。付着領域2における反射器9内での5は金属イオンと付着イオンの移動の軌跡である。付着領域2内に入った金属イオンは反射器9の入口に入り、反射器9内を移動する。共通領域10には真空ポンプ7が付設されている。被測定ガス(試料ガス)は、被測定ガスの導入機構30によって付着領域2の反射器9内に導入される。

# [0037]

金属イオン発生および質量分析の共通領域 10 と付着領域 2 との間に 2 つ孔付き隔壁 1 1 によって圧力差が生じており、付着領域 2 は被測定ガスが導入されて約 1 P a の圧力となっているのに対して、金属イオン発生と質量分析の共通領域 1 0 は約 1 0  $^{-3}$  P a となっている。金属イオンは L i  $^+$  が使用されている。L i  $^+$  の 1 0  $^{-3}$  P a での平均自由行程は 1 0 m 程度となっているので、イオンはいずれの領域でも雰囲気ガスと衝突せずに進む自由飛行となっている。

# [0038]

エミッタ4には図示しない電源によって約15 Vのバイアス電圧が印加されているので、エミッタ4から放出された金属イオンは、約15 e Vの並進エネルギを持って隔壁11の孔11aを通過し付着領域2に輸送される。二重半球型の反射器9の内外の半球9a,9bには電圧が印加され、約15 e Vの並進エネルギのイオンが通過できるような静電界が形成されている。そこで、金属イオンは二重半球型の反射器9を通過するが、その途中で被測定ガスに付着して付着イオンとなる。付着イオンとなってもイオンの移動の軌道は変わらない。当初の軌道のまま進み隔壁11の孔11bを通過して質量分析計8まで輸送され、質量分析が行われる。このような静電界では、角度的に広がりを持って付着領域2に入射されたイオンも集束する機能がある。

## [0039]

第1実施形態によれば、金属イオンは常に約15eVの並進エネルギを持って 飛行するので、減速による付着効率の向上は期待できない。しかしながら、前述 した(a)と(b)を除けば、すべての課題の解決に効果がある。

# [0040]

次に図2を参照して本発明の第2実施形態を説明する。図2は本発明の第2実施形態に係るイオン付着質量分析装置の内部構造を概略的に示す縦断面図である。図2において、図1で説明した要素と実質的に同一の要素には同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。以下では第2実施形態の特徴的な構成が説明される。

#### [0041]

図2に示すごとく、第2実施形態では、付着領域2には平行電界を作るように構成された反射器12が設けられている。共通領域10に配置されるエミッタ4と質量分析計8は、エミッタ4から放出される金属イオンの放出方向、質量分析計8の軸方向が付着領域側の1つの点に向くように傾斜されている。またエミッタ4と質量分析計8の傾斜に対応して隔壁11に形成される2つの孔11a,11bもイオンを誘導する方向を傾斜させるようにして形成されている。その他の構成は第1実施形態で説明された構成と同じである。

# [0042]

平行電界の反射器 1 2 では、図 2 中、右側(共通領域 1 0 側)のグリッド 1 2 a と左側の板 1 2 b の間に平行な静電界を形成している。グリッド 1 2 は、ワイヤで編まれたメッシュ状の部材、あるいは多数の孔を有する板材である。反射器 1 2 では、静電界により、正電荷のイオンは図 2 中右方向に力を受けるようになっている。エミッタ4 から左側やや上方に向けて放出された金属イオンは、この静電界により減速されて 3 0°程度の鋭角で反射される。反射時には、並進エネルギのうち図の水平方向成分は完全にゼロとなり、上下方向成分だけしか残らない。当初の並進エネルギをEとすると、反射時に残っている並進エネルギはE・sin(30°/2)となる。このように減速された Li<sup>+</sup>は被測定ガスの分子に効率よく付着する。反射器 1 2 において生成された付着イオンは、同じ静電界により右側やや上方に向けてリターンして、質量分析計 8 に輸送される。

# [0043]

第2実施形態によれば、第1実施形態に比べると、構造が簡単な上に、金属イオンの減速が行われるので、付着効率の向上が期待できる。他方、イオンを集束

する機能はない。すなわち前述した(c)を除けば、すべての課題の解決に効果がある。

# [0044]

次に図3を参照して本発明の第3実施形態を説明する。図3は本発明の第3実施形態に係るイオン付着質量分析装置の内部構造を概略的に示す縦断面図である。図3において、図1および図2で説明した要素と実質的に同一の要素には同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。以下では第3実施形態の特徴的な構成が説明される。

#### [0045]

図3に示すごとく、第3実施形態では、付着領域2に曲面電界を生成するように構成された反射器13が設けられる。その他の構成は、第2実施形態の構成と同じである。

# [0046]

曲面電界の反射器13では、右側のグリッド13aと左側の板13bの間には立体的な曲面(例えば放物面)を持った静電界が形成され、この静電界の領域に侵入した正電荷のイオンは右側やや中心方向に力を受けるようになっている。反射の過程で生成した付着イオンは静電界により右側やや上方にむけて加速されるが、この時にやや中心方向を向くので質量分析計に効率的に輸送される。

#### [0047]

第3実施形態によれば、第2実施形態に比べると、イオンを集束する機能がある。すなわち、前述した(a)~(g)のすべての課題の解決について効果がある。

## [0048]

次に図4を参照して本発明の第4実施形態を説明する。図4は本発明の第4実施形態に係るイオン付着質量分析装置の内部構造を概略的に示す縦断面図である。図4において、図1および図2で説明した要素と実質的に同一の要素には同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。以下では第4実施形態の特徴的な構成が説明される。

## [0049]

図4に示すごとく、第4実施形態では、付着領域2にグリッドレス曲面電界の反射器14が設けられる。その他の構成は、第2実施形態等の構成と同じである。グリッドレス曲面電界の反射器14では、金属イオンあるいは付着イオンが透過するグリッドは存在しないが、しみ出し電界によって図3に類似した立体的な曲面を持った静電界が形成される。

#### [0050]

第4実施形態によれば、例えば第3実施形態に比べると、グリッドが存在しないため構造が簡単な上、グリッドに衝突・吸収されて損失するイオンがない。またグリッドではLiや被測定ガスの生成物が表面に堆積し、チャージアップが発生し感度低下を招くおそれがあるが、本実施形態ではこのような不具合が解消される。

#### [0051]

次に図5を参照して本発明の第5実施形態を説明する。図5は本発明の第5実施形態に係るイオン付着質量分析装置の内部構造を概略的に示す縦断面図である。図5において、図1および図2等で説明した要素と実質的に同一の要素には同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。以下では第5実施形態の特徴的な構成が説明される。

#### [0052]

図5に示すごとく、第5実施形態では、付着領域2にグリッドレス曲面電界の 反射器14が設けられ、さらに反射器14の内部に例えば3つの補正電極15が 設けられる。第5実施形態は第4実施形態の変形例であり、その他の構成は、第 4実施形態の構成と同じである。

#### [0053]

補正電極15には微少な電圧が印加され、反射器14による静電界に補正電極15による補正電界が重畳される。これによって金属イオンおよび付着イオンの移動軌道の調整が行われる。例えば、質量分析計8に向かう付着イオンの軌道が図5中の上方にずれている場合は、上側にある補正電極15により正電位を印加して付着イオンの軌道を下方に移動させる。また付着イオンの集束が足らない場合は、左側にある補正電極15により負電位を印加して付着イオンの集束効果を

強くする。

[0054]

第5実施形態の構成によれば、イオンの軌道の調整だけでなく、調整が必要かどうかを判断するために軌道の観察を行うこともできる。補正電極15により付着イオンの軌道を2次元走査して検出信号を輝度とした画像を表示すると、画像上で明るい部分が中心に集中していれば調整は不要、中心以外にずれている、あるいは広がっていれば調整が必要となる。

[0055]

第5実施形態によれば、常に最大感度での測定を行うことができるという利点を有している。

[0056]

次に図6を参照して本発明の第6実施形態を説明する。図6は本発明の第6実施形態に係るイオン付着質量分析装置の内部構造を概略的に示す縦断面図である。図6において、図1と図3で説明した要素と実質的に同一の要素には同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。第6実施形態は、第1と第3の実施形態を組合せて構成される変形例である。以下では第6実施形態の特徴的な構成が説明される。

[0057]

図6に示すごとく、第6実施形態では、付着領域2に回転楕円体状電界を生成するように構成された反射器16が設けられる。その他の構成は、前述した実施形態と同じである。

[0058]

付着領域2へ金属イオンが入射する点、および付着領域2から付着イオンが射 出する点は、回転楕円体における2つの焦点に一致している。

[0059]

理想的な条件として回転楕円体内面で鏡面反射する場合、1つの焦点から入射 した光は、どのような角度であってもすべて他の焦点に集束することが知られて いる。従って第6実施形態によれば、例えば第3実施形態に比べると、イオンの 集束効率がより高くなるという利点を有する。 [0060]

次に図7を参照して本発明の第7実施形態を説明する。図7は本発明の第7実施形態に係るイオン付着質量分析装置の内部構造を概略的に示す縦断面図である。図7において、図1等で説明した要素と実質的に同一の要素には同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。以下では第7実施形態の特徴的な構成が説明される。

[0061]

図7に示すごとく、第7実施形態では、付着領域2にグリッドレス回転楕円体 状電界の反射器17が設けられる。その他の構成は、第6実施形態の構成と同じ である。この実施形態では、反射器17によるしみ出し電界によって図6で説明 した静電界に類似した回転楕円体状の静電界が形成される。この実施形態によれ ば、第6実施形態に比べると、グリッドが存在しないため、構造が簡単になり、 感度面で有利であるという利点を有する。

[0062]

次に図8を参照して本発明の第8実施形態を説明する。図8は本発明の第8実施形態に係るイオン付着質量分析装置の内部構造を概略的に示す縦断面図である。図8において、図1等で説明した要素と実質的に同一の要素には同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。以下では第8実施形態の特徴的な構成が説明される。

[0063]

図8に示すごとく、第8実施形態では、付着領域2に球体状電界を生成するように形成された反射器18が設けられる。その他の構成は、図6で説明した構成と同じである。第8実施形態の構成では、付着領域2へ金属イオンが入射する点、および付着領域2から付着イオンが射出する点は、より中心に近づいている。第8実施形態によれば、反射器の製作がより容易であるという利点を有する。

[0064]

次に図9を参照して本発明の第9実施形態を説明する。図9は本発明の第9実施形態に係るイオン付着質量分析装置の内部構造を概略的に示す縦断面図である。図9において、図1等で説明した要素と実質的に同一の要素には同一の符号を

付し、その詳細な説明は省略する。以下では第9実施形態の特徴的な構成が説明 される。

[0065]

図9に示すごとく、第9実施形態では、グリッドレス球体状電界を生成するように構成された反射器19が設けられる。反射器19によって、しみ出し電界によって図8で説明された類似した球体状の静電界が形成される。その他の構成は、第8実施形態で説明した構成と同じである。この実施形態によれば、グリッドが存在しないため、構造が簡単であり、感度面で有利である。

[0066]

次に図10を参照して本発明の第10実施形態を説明する。図10は本発明の第10実施形態に係るイオン付着質量分析装置の内部構造を概略的に示す縦断面図である。図10において、図1や図8等で説明した要素と実質的に同一の要素には同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。以下では第10実施形態の特徴的な構成が説明される。

[006.7]

図10に示すごとく、第10実施形態では、付着領域2に球体状電界を生成するように形成された反射器18が設けられ、付着領域2と共通領域10の間に1つの共通孔20aを有する隔壁20が設けられる。エミッタ4から付着領域2へ金属イオンが入射する点、および付着領域2から質量分析計8への付着イオンが射出する点は、同位置であり、共に共通孔付き隔壁20の1つの孔20aで行われる。その他の構成は、第8実施形態の構成と同じである。

[0068]

第10実施形態によれば、隔壁20の孔が1つなので圧力差の発生が有利となる。またどこの場所でも静電界の電気力線が中心の孔(射出点)20aの方向を向いているので、自由飛行せずに雰囲気ガスと衝突して並進エネルギを失った一部の付着イオンも射出点に集束させることができ、感度のよい測定を行うことができる。

[0069]

次に図11を参照して本発明の第11実施形態を説明する。図11は本発明の

第11実施形態に係るイオン付着質量分析装置の内部構造を概略的に示す縦断面 図である。図11において、図1や図10等で説明した要素と実質的に同一の要 素には同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。以下では第11実施形態 の特徴的な構成が説明される。

[0070]

図11に示すごとく第11実施形態では、共通領域10に静電偏向器21が設 けられ、かつ付着領域2と共通領域10の間には共通孔20aを備えた隔壁20 が設けられている。付着領域2には、第10実施形態と同様に、球体状電界を生 成するように形成された反射器18が配置されている。静電偏向器21では、エ ミッタ4から放出される金属イオンを90°曲げる偏向静電界と、付着イオンを 直進させる無電界の状態が高速で切り換えられる構成が設けられる。この構成は 、静電偏向器21における図11中に示された左右の部分(曲線状に形成された 板部材)において印加される左右の電圧(左側がマイナス電圧、右側がプラス電 圧)の両者をマイクロ秒の時間間隔で所定電圧とゼロ電圧とに交互に切り換える と共に、その中間にゼロ電位となる時間を設定することにより成る。これにより 、静電偏向器21にマイナスとプラスの電圧を印加したときにはイオンは90° 偏向し、ゼロ電位に保持されるときには反射してくるイオンが質量分析計の方へ 直進することになる。エミッタ4から発生した金属イオンは静電偏向器により9 0°曲げられて共通孔付き隔壁20の孔20aを通過して付着領域2に輸送され る。付着領域2で生成した付着イオンは、共通孔付き隔壁20の孔20aを通過 した後、無電界となっている静電偏向器21を直進して質量分析計8に輸送され る。静電偏向器21の切り換え時間を、金属イオンの輸送・反射、付着イオンの 生成・輸送に要する時間に合致させることにより、大きな損失なしに測定が行わ れる。その他の構成・動作は第8実施形態と同じである。

[0071]

第11実施形態によれば、180°反射となるので反射時に完全な停止状態となり、付着の効率が非常に高くなる。

[0072]

以上の各実施形態に関して、本発明は以下のような変更を行うことも可能であ

る。

#### [0073]

付着領域2の圧力はイオンが自由飛行する1 P a としたが、必ずしも完全な自由飛行が必須の条件ではない。一部あるいは全部のイオンが雰囲気ガスと衝突する条件ではイオンの集束などで多少問題が発生する場合もあるが、致命的とはならない。特に第10と第11の実施形態では集束の問題も発生しない。

#### [0074]

金属イオンとして $Li^+$ を使用したが、これに限定されず、 $K^+$ 、 $Na^+$ 、 $Rb^+$ 、 $Cs^+$ 、 $A1^+$ 、 $Ga^+$ 、 $In^+$ などに適用できる。また質量分析計8としては $QR^+$ の、 $RR^+$ の、

## [0075]

被測定ガスとしては最初からガス状のもの以外に、本来は固体・液体であっても何らかの手段でガス状になっていれば良い。また、本装置を他の成分分離装置、例えばガスクロマトグラフや液体クロマトグラフに接続して、ガスクロマトグラフ/質量分析装置(GC/MS)、液体クロマト/質量分析装置(LC/MS)とすることもできる。

#### [0076]

#### 【発明の効果】

以上の説明で明らかなように本発明によれば、付着イオン質量分析装置において、金属イオン発生領域と質量分析領域は共通の領域を形成し、付着領域は共通の領域に隣接して設け、付着領域に金属イオン発生領域から付着領域内に導入された金属イオンを反射させることにより質量分析領域へ導く静電界発生部を備えたため、高い測定感度により微量成分を検出でき、質量分析計の擾乱、エミッタ劣化、装置サイズ、直接サンプリング等の問題を解決し、さらに産業に幅広く適用することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【図1】

本発明の第1実施形態に係るイオン付着質量分析装置の内部構造を概略的に示す縦断面図である。

#### 【図2】

本発明の第2実施形態に係るイオン付着質量分析装置の内部構造を概略的に示す縦断面図である。

#### 【図3】

本発明の第3実施形態に係るイオン付着質量分析装置の内部構造を概略的に示す縦断面図である。

#### 【図4】

本発明の第4実施形態に係るイオン付着質量分析装置の内部構造を概略的に示す縦断面図である。

#### 【図5】

本発明の第5実施形態に係るイオン付着質量分析装置の内部構造を概略的に示す縦断面図である。

#### 【図6】

本発明の第6実施形態に係るイオン付着質量分析装置の内部構造を概略的に示す縦断面図である。

#### 【図7】

本発明の第7実施形態に係るイオン付着質量分析装置の内部構造を概略的に示す縦断面図である。

# 【図8】

本発明の第8実施形態に係るイオン付着質量分析装置の内部構造を概略的に示す縦断面図である。

# 【図9】

本発明の第9実施形態に係るイオン付着質量分析装置の内部構造を概略的に示す縦断面図である。

#### 【図10】

本発明の第10実施形態に係るイオン付着質量分析装置の内部構造を概略的に

示す縦断面図である。

# 【図11】

本発明の第11実施形態に係るイオン付着質量分析装置の内部構造を概略的に 示す縦断面図である。

# 【図12】

従来のイオン付着質量分析装置の内部構造を概略的に示す縦断面図である。

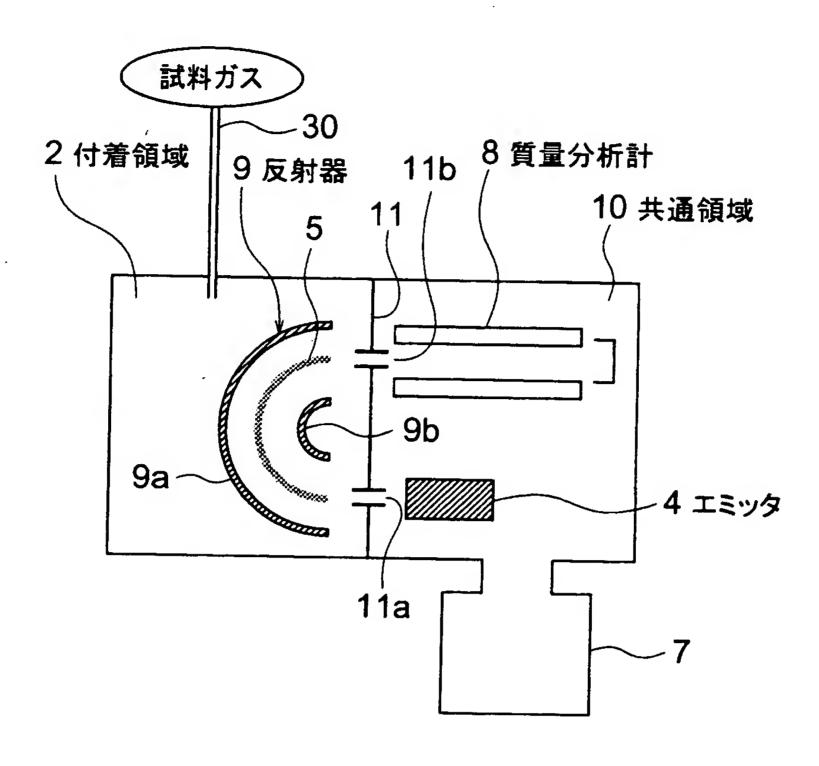
# 【符号の説明】

1	金属イオン発生領域
2	付着領域
3	質量分析領域
4	エミッタ
5	金属イオンと付着イオンの軌跡
6	孔付き隔壁
7	真空ポンプ
8	質量分析計
9	二重半球型の反射器
1 0	金属イオン発生と質量分析の共通領域
1 1	2つ孔付き隔壁
1 2	平行電界の反射器
1 3	曲面電界の反射器
1 4	グリッドレス曲面電界の反射器
1 5	補正電極
1 6	回転楕円体状電界の反射器
1 7	グリッドレス回転楕円体状電界の反射器
1 8	球体状電界の反射器
1 9	グリッドレス球体状電界の反射器
2 0	共通孔付き隔壁
2 1	静電偏向器

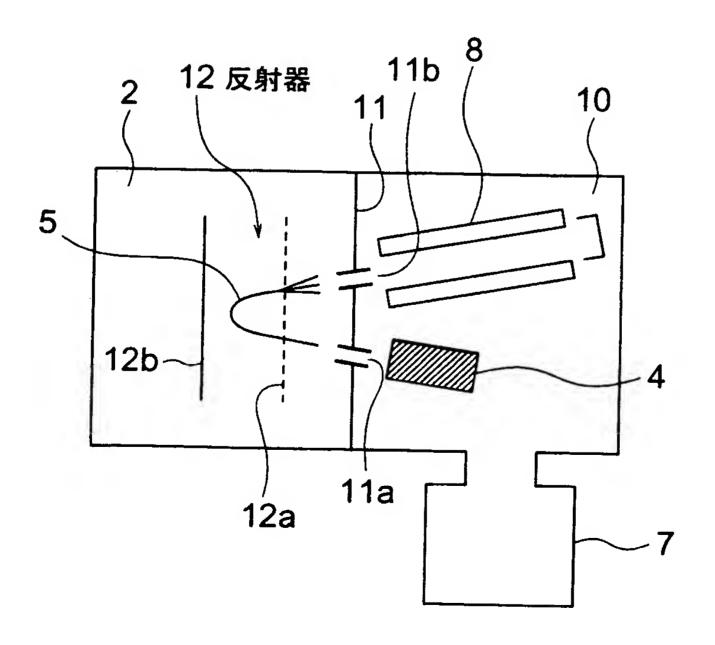
【書類名】

図面

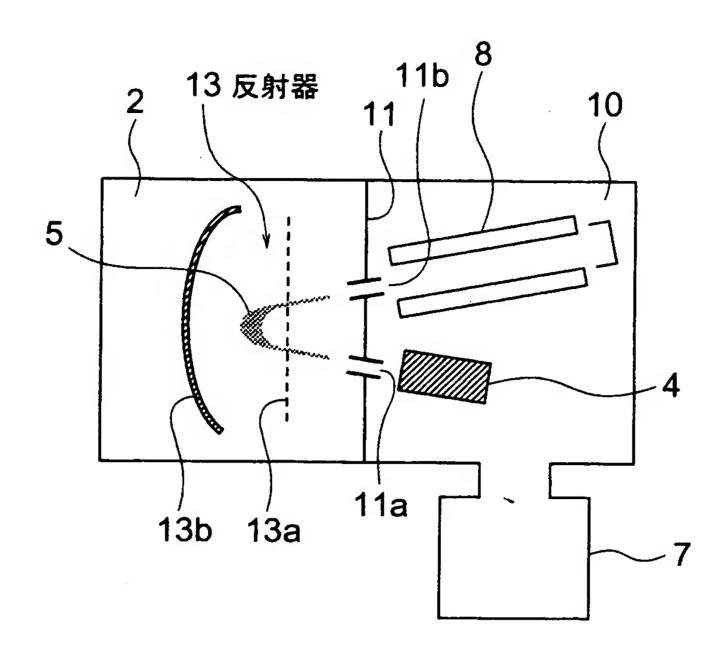
【図1】



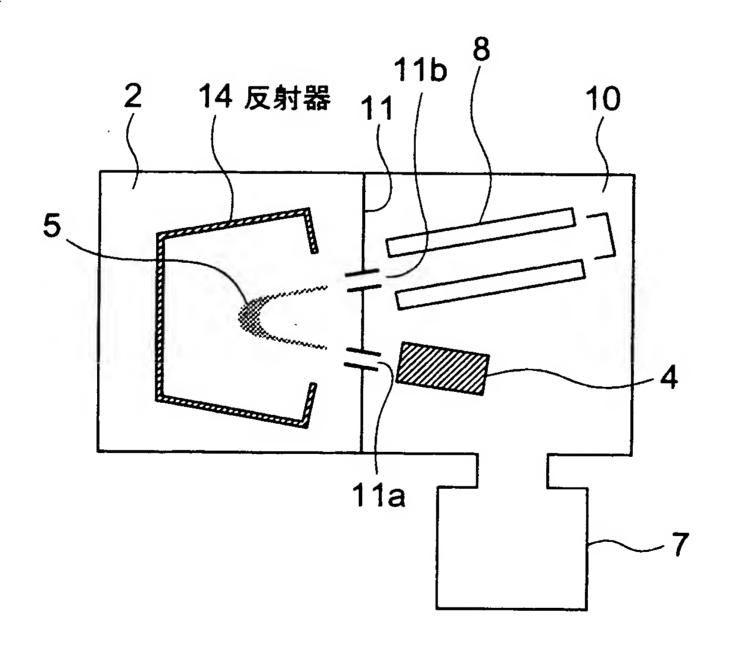
【図2】



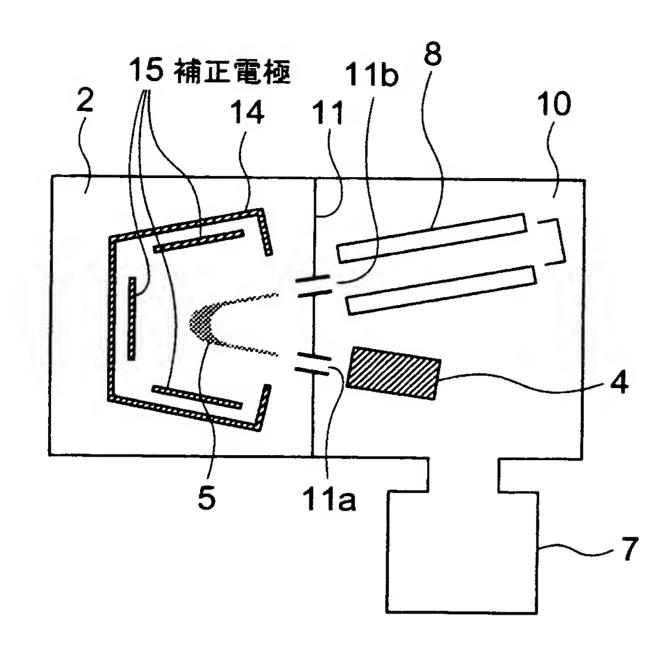
【図3】



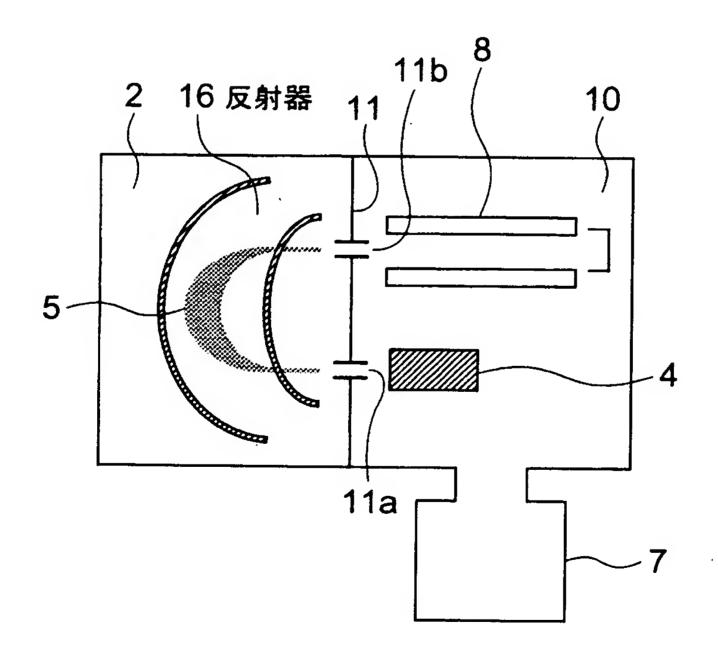
[図4]



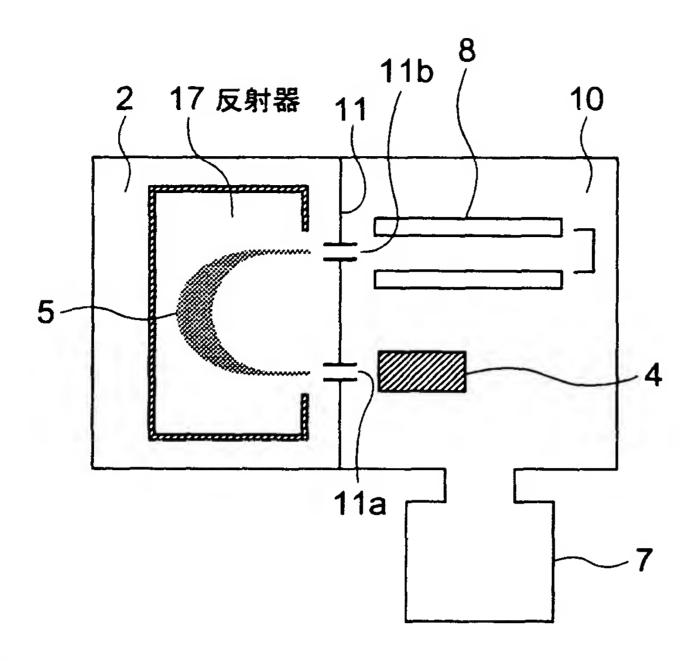
# 【図5】



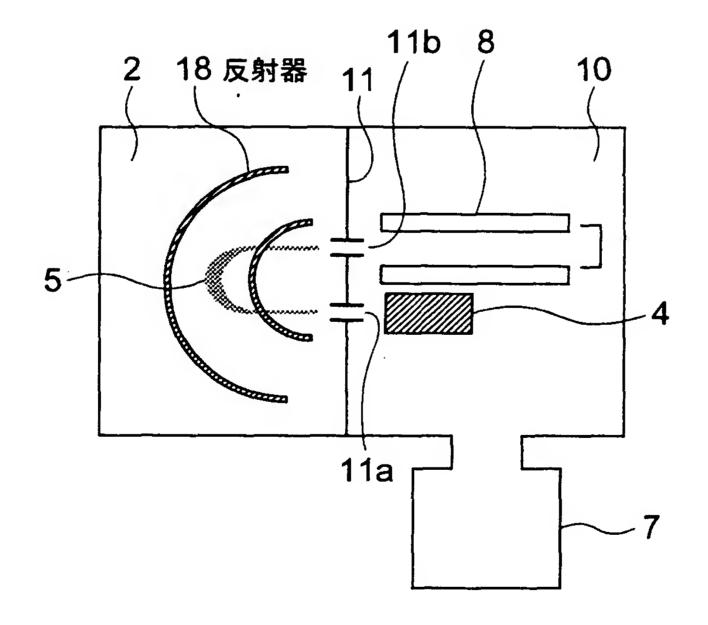
# 【図6】



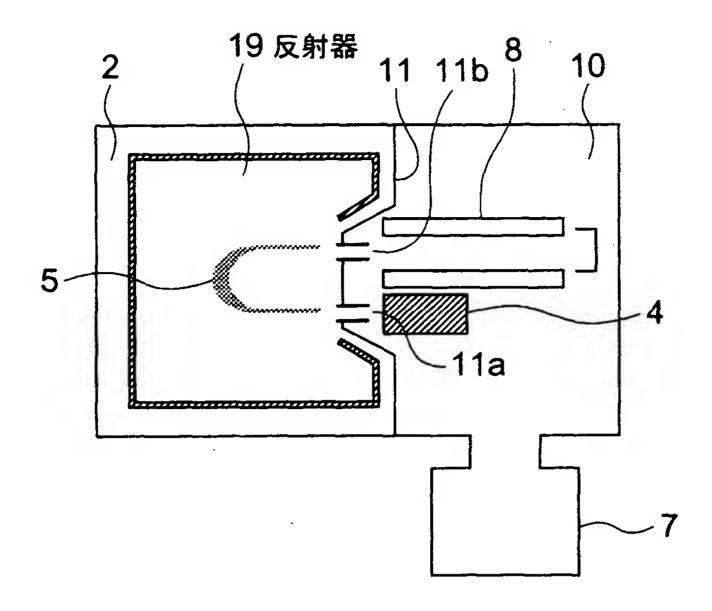
【図7】



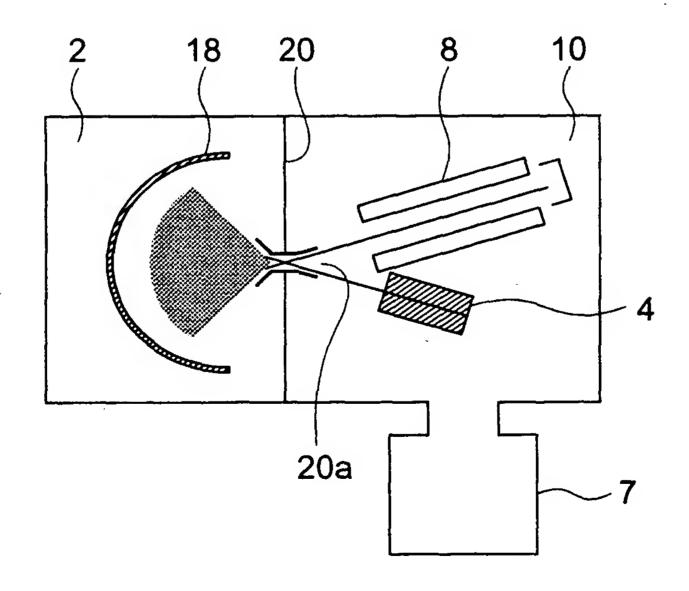
【図8】



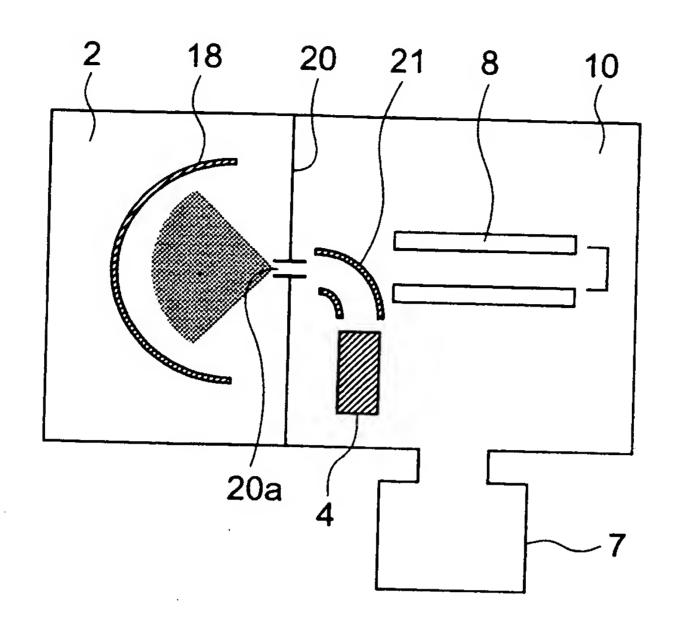
【図9】



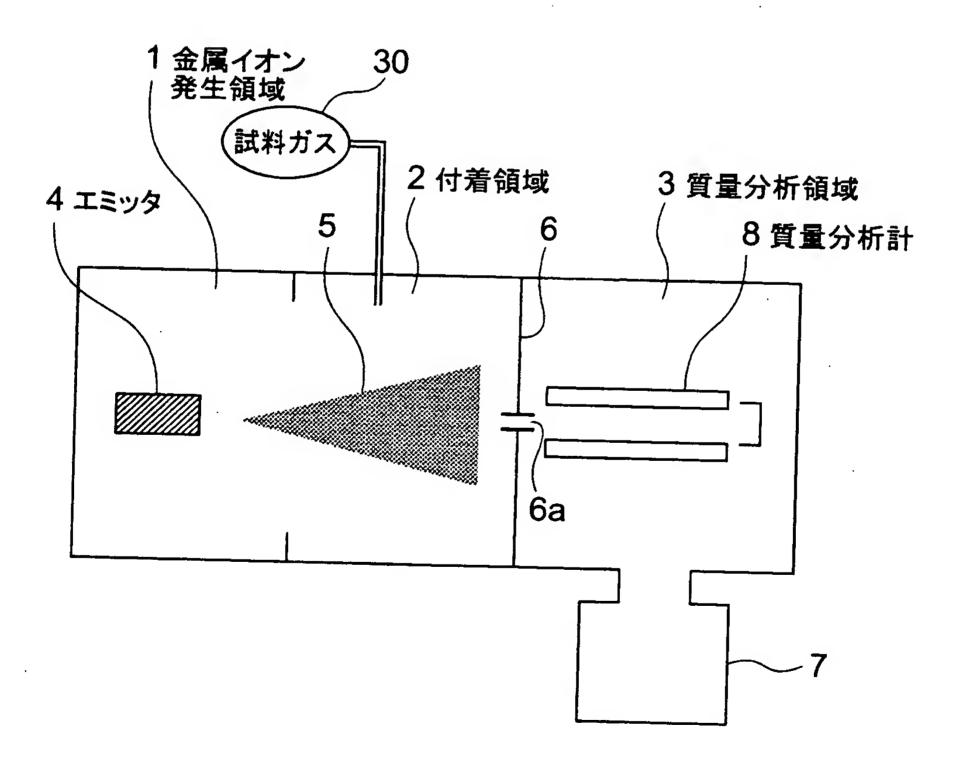
【図10】



【図11】



# 【図12】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 高い測定感度により微量成分を検出でき、質量分析計の擾乱、エミッタ劣化、装置サイズ、直接サンプリング等の問題を解決し、産業に幅広く適用できる一般的な分析方法としての反射型イオン付着質量分析装置を提供する。

【解決手段】 この反射型イオン付着質量分析装置は、金属イオン発生領域1と付着領域2と質量分析領域3を備え、金属イオン発生領域と質量分析領域は共通の領域10として形成され、付着領域は共通の領域に隣接して設けられる。付着領域には、金属イオン発生領域から付着領域内に導入された金属イオンを反射させることにより質量分析領域へ導く静電界を形成する静電界発生部9を備える。

【選択図】 図1

# 出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000227294]

1. 変更年月日

1995年11月24日

[変更理由]

名称変更

住 所

東京都府中市四谷5丁目8番1号

氏 名

アネルバ株式会社